



آشکارساز نیمه‌هادی مدل TPD3



حسگر نیمه‌هادی TPD3 با مساحت کمتر از 7.5 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 900 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشکارسازی پرتوهای UV-A تا فرسرخ نزدیک به‌شمار می‌رود.

این حسگر با زمان خیزش و افت کمتر از 200 نانوثانیه، توان تحمل ولتاژ بایاس تا 60 ولت و جریان تاریک 30 نانوآمپر می‌تواند بخش قابل توجهی از پرتو لیزرهای پالسی و پیوسته را آشکارسازی کند.



مشخصات فنی



Si Photodiode		نوع حسگر
mm ²	2.7 x 2.7	سطح حساس
mm	∅ 3	سطح ورودی
nm	430-1100	بازه طول‌موج
V	< 60	ولتاژ بایاس
ns	≤ 100	زمان خیزش
ns	≤ 100	زمان افت
fW/√Hz	50	توان معادل نویز (نوعی)
nA	< 30	جریان تاریک نوعی
pF (f=1MHz)	70	ظرفیت خازنی اتصال
nm	900	بیشینه حساسیت

ویژگی‌ها



اتصال مستقیم به اسیلوسکوپ جهت نمایش داده‌ها
 آشکارسازی در بازه طول موجی 430 الی 1100 نانومتر
 دقت بالا و کاربری آسان
 قابلیت آشکارسازی باریکه‌های نوری پالسی و پیوسته
 دارای استاندارد رزوه‌های C-Mount
 پوشش آنودایز بدنه جهت جلوگیری از بازتاب

430
~
1100
nm

0.2μs



Guarantee
6 mon.

